



## S8550M (3CG8550M)

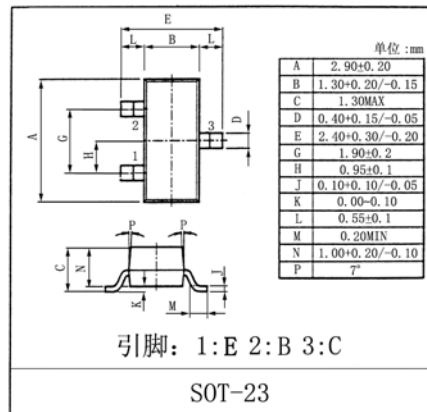
## 硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于功率放大电路。/Purpose: Power amplifier applications.

特点:与 S8050M(3DG8050M) 互补。/Features: Complementary pair with S8050M(3DG8050M).

极限参数/Absolute maximum ratings( $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
$V_{CB0}$	-40	V
$V_{CE0}$	-25	V
$V_{EB0}$	-6.0	V
$I_C$	-800	mA
$I_B$	-200	mA
$P_C$	450	mW
$T_j$	150	$^{\circ}\text{C}$
$T_{stg}$	-65~150	$^{\circ}\text{C}$



电性能参数/Electrical characteristics( $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
$V_{CB0}$	$I_C=-0.1\text{mA}$ $I_E=0$	-40			V
$V_{CE0}$	$I_C=-2.0\text{mA}$ $I_B=0$	-25			V
$V_{EB0}$	$I_E=-0.1\text{mA}$ $I_C=0$	-6.0			V
$I_{CB0}$	$V_{CB}=-35\text{V}$ $I_E=0$			-0.1	$\mu\text{A}$
$I_{EB0}$	$V_{EB}=-6.0\text{V}$ $I_C=0$			-0.1	$\mu\text{A}$
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-1.0\text{V}$ $I_C=-100\text{mA}$	85		300	
$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-1.0\text{V}$ $I_C=-500\text{mA}$	40			
$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=-1.0\text{V}$ $I_C=-5.0\text{mA}$	45			
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}$ $I_B=-50\text{mA}$		-0.28	-0.6	V
$V_{BE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}$ $I_B=-50\text{mA}$		-0.98	-1.2	V
$V_{BE}$	$V_{CE}=-1.0\text{V}$ $I_C=-10\text{mA}$		-0.66	-1.0	V
$f_T$	$V_{CE}=-10\text{V}$ $I_C=-50\text{mA}$	100	200		MHz
$C_{ob}$	$V_{CB}=-10\text{V}$ $I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		15		pF

$h_{FE(1)}$  分档、印章/ $h_{FE(1)}$  classifications、Marking:

$h_{FE(1)}$ 分档 $h_{FE(1)}$ Classifications	B	C	D
$h_{FE(1)}$ 范围 $h_{FE(1)}$ Range	85~160	120~200	160~300
印章 Marking	HY4B	HY4C	HY4D

